

OBSAH

| | | |
|----------|--|----|
| 1. | ÚVOD | 9 |
| 1.1. | Úloha a poslání mikroelektroniky | 9 |
| 1.2. | Charakteristika rozvoje integrovaných obvodů | 10 |
| 1.2.1. | Integrace součástek | 11 |
| 1.2.2. | Integrace funkce | 12 |
| 1.3. | Problémy aplikace integrovaných obvodů | 18 |
| 2. | PROJEKTOVÁNÍ INTEGROVANÝCH OBVODŮ LSI | 19 |
| 2.1. | Postup při projektování IO | 19 |
| 2.1.1. | Důvody pro automatizaci návrhu | 20 |
| 2.1.2. | Systém programů pro automatizovaný návrh IO | 21 |
| 2.1.3. | Systémy programů pro návrh podle vzoru („ruční návrh“) | 23 |
| 2.2. | Modelování systémů na úrovni meziregistrových přenosů | 24 |
| 2.2.1. | Skupinové schéma počítače | 24 |
| 2.2.2. | Instrukce | 27 |
| 2.2.3. | Vývojový diagram počítače | 29 |
| 2.2.4. | Popis hypotetického počítače v jazyku CDL | 30 |
| 2.3. | Modelování na úrovni logické funkce | 34 |
| 2.3.1. | Konvenční simulátory | 35 |
| 2.3.2. | Simulátory logické funkce se vstupními údaji získanými přímo z masek | 37 |
| 2.3.3. | Reprezentace smíšeného schématu grafem | 41 |
| 2.3.3.1. | Svaz | 43 |
| 2.3.3.2. | Směr hran | 44 |
| 2.3.3.3. | Stavy signálů | 45 |
| 2.3.3.4. | Pravdivostní tabulky hran a vrcholů typu A, OU | 46 |
| 2.3.3.5. | Pravdivostní tabulky vrcholů typu L, LM | 48 |
| 2.3.4. | Simulátor LOMACH — MIXED | 50 |
| 2.4. | Modelování na úrovni elektrického schématu | 51 |
| 2.4.1. | Modelování elementárních prvků | 54 |
| 2.4.2. | Zvětšení kapacity elektrických simulátorů | 56 |
| 2.4.2.1. | Zjednodušená časová simulace | 56 |
| 2.4.2.2. | Makromodely | 58 |
| 2.4.2.3. | Princip latentnosti | 60 |
| 2.4.2.4. | Hybridní simulace | 62 |
| 2.4.2.5. | Paralelní zpracování dat | 64 |
| 2.4.3. | Elektrické a hybridní simulátory pro návrh IO v ČSSR | 64 |
| 2.4.3.1. | Program SIC | 65 |
| 2.4.3.2. | Program HSIC | 67 |
| 2.4.3.3. | Program REGRES | 68 |
| 2.4.4. | Shrnutí | 69 |
| 2.5. | Návrh masek integrovaných obvodů | 70 |
| 2.5.1. | Návrh integrovaných obvodů symbolickým jazykem | 71 |
| 2.5.2. | Návrh integrovaných obvodů na bázi standardních buněk | 75 |
| 2.5.3. | Návrh integrovaných obvodů na bázi hradlových polí | 79 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 2.5.4. | Návrh integrovaných obvodů velmi velké integrace | 81 |
| 2.5.5. | Verifikace návrhu masek | 82 |
| 2.6. | Zvláštnosti návrhu analogových integrovaných obvodů | 85 |
| 2.7. | Diagnostika IO LSI | 90 |
| 2.7.1. | Účel diagnostiky pro IO LSI | 90 |
| 2.7.2. | Návrh snadno testovatelných obvodů | 92 |
| 2.7.3. | Volba modelu poruch a minimalizace poruch | 94 |
| 2.7.4. | Simulace bezporuchového obvodu | 96 |
| 2.7.5. | Simulace obvodu s poruchami | 96 |
| 2.7.6. | Generování testu | 97 |
| 2.7.7. | Lokalizace poruch | 99 |
| 3. | TECHNOLOGIE VÝROBY INTEGROVANÝCH OBVODŮ LSI | |
| 3.1. | Definice pojmu | 103 |
| 3.2. | Technologie materiálu | 110 |
| 3.2.1. | Funkční a nosné materiály v mikroelektronice | 110 |
| 3.2.2. | Výroba monokrystalu | 111 |
| 3.2.3. | Čištění monokrystalu od strukturních nečistot | 112 |
| 3.2.4. | Dotace monokrystalu | 113 |
| 3.2.5. | Krystalografická orientace | 113 |
| 3.2.6. | Řezání krystalu na desky | 114 |
| 3.2.7. | Broušení desek | 114 |
| 3.2.8. | Leštění desek | 114 |
| 3.2.9. | Leptání desek | 115 |
| 3.2.10. | Mytí desek | 115 |
| 3.2.11. | Podložky (substráty) integrovaných obvodů | 115 |
| 3.2.12. | Epitaxe | 115 |
| 3.2.13. | Oxidace a nitridace | 115 |
| 3.3. | Technologie obvodových motivů | 116 |
| 3.3.1. | Operace pro výrobu integrovaného obvodu | 116 |
| 3.3.2. | Sled operací pro vytvoření tranzistoru | 119 |
| 3.3.3. | Závěrečná operace | 121 |
| 3.3.4. | Podrobnosti technologických operací | 121 |
| 3.3.4.1. | Litografie | 121 |
| 3.3.4.2. | Leptání | 144 |
| 3.3.4.3. | Nanášení materiálu | 147 |
| 3.3.4.4. | Oxidace křemíku | 151 |
| 3.3.4.5. | Způsoby lokální dotace | 154 |
| 3.3.4.6. | Vytváření spojů | 156 |
| 3.4. | Obvodové principy logických obvodů | 159 |
| 3.5. | Trendy technologie integrovaných obvodů | 163 |
| 3.6. | Montážní technologie | 165 |
| 3.7. | Organizace výroby integrovaných obvodů LSI. Organizace výrobní linky a činnosti na jednotlivých pracovištích | 169 |
| 3.7.1. | Podmínky zabezpečující potřebné výtěžnosti hromadných operací | 171 |
| 3.7.2. | Pracovní masky | 174 |
| 3.7.3. | Fotolitografické procesy | 175 |
| 3.7.4. | Vysokoteplotní procesy | 176 |
| 3.7.5. | Iontová implantace | 177 |
| 3.7.6. | Leptání a praní po leptání | 178 |
| 3.7.7. | Metalizace | 179 |
| 3.7.8. | Mezioperační kontroly | 179 |
| 3.7.9. | Montážní operace | 182 |
| 3.7.10. | Výstupní kontrola | 183 |
| 3.7.11. | Problémy bezpečnosti práce | 184 |
| 3.7.12. | Další zlepšování technologie hromadné výroby složitých obvodů | 184 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 3.8. | Řízení technologického postupu s využitím výpočetní techniky | 185 |
| 3.9. | Magnetické bublinové paměti | 191 |
| 3.9.1. | Základní pojmy a princip činnosti | 191 |
| 3.9.2. | Fyzika magnetických domén | 192 |
| 3.9.2.1. | Výmenná energie | 192 |
| 3.9.2.2. | Energie anizotropie | 193 |
| 3.9.2.3. | Magnetostatická energie | 194 |
| 3.9.2.4. | Blochova stěna | 195 |
| 3.9.2.5. | Doménová struktura v jednoosých látkách | 196 |
| 3.9.3. | Funkční prvky bublinových pamětí | 200 |
| 3.9.3.1. | Translační prvky | 201 |
| 3.9.3.2. | Generace, replikace, detekce a anihilace bublin | 203 |
| 3.9.3.3. | Bublinový čip a jeho organizace | 204 |
| 3.9.4. | Bublinové materiály a výroba čipů | 204 |
| 3.9.4.1. | Krystaly GGG | 206 |
| 3.9.4.2. | Epitaxní vrstvy | 206 |
| 3.9.4.3. | Zhotovení nadstruktury | 207 |
| 3.9.5. | Mechanická struktura MBP | 208 |
| 3.9.6. | Přehled komerčních bublinových pamětí a jejich použití | 209 |
| 3.9.6.1. | Podpůrné integrované obvody | 211 |
| 3.9.6.2. | Přednosti MBP | 211 |
| 3.9.6.3. | Použití MBP | 212 |
| 3.9.7. | Prognóza MBP | 213 |

4. MĚŘENÍ INTEGROVANÝCH OBVODŮ A MĚŘICÍ TECHNIKA

| | | |
|----------|--|-----|
| 4.1. | Úkol měření | 217 |
| 4.1.1. | Strategie měření ve výrobě | 218 |
| 4.1.2. | Technické podmínky | 219 |
| 4.2. | Zjišťování spolehlivosti u výrobce i uživatele | 220 |
| 4.2.1. | Zkoušky spolehlivosti | 221 |
| 4.3. | Měření elektrických parametrů technologie | 224 |
| 4.3.1. | Parametry elektrického modelu | 226 |
| 4.4. | Měření integrovaných obvodů LSI | 227 |
| 4.4.1. | Měření statických parametrů | 227 |
| 4.4.2. | Dynamické parametry | 231 |
| 4.4.3. | Testování logické funkce | 232 |
| 4.4.4. | Měření za mezních teplot | 233 |
| 4.4.5. | Měření pro spolehlivostní zkoušky | 234 |
| 4.5. | Zpracování výsledků měření a testů | 234 |
| 4.6. | Organizace testovacího pracoviště | 240 |
| 4.7. | Měřicí technika | 242 |
| 4.7.1. | Technika pro měření elektrických parametrů technologie | 242 |
| 4.7.2. | Technika pro měření laboratorních vzorků | 243 |
| 4.7.3. | Technika pro měření funkčních vzorků | 243 |
| 4.7.3.1. | Minipočítáč a jeho konfigurace | 243 |
| 4.7.3.2. | Sestava testeru | 244 |
| 4.7.3.3. | Potřebné jednotky a moduly | 244 |
| 4.7.3.4. | Programové vybavení | 245 |
| 4.7.4. | Technika pro testování ve výrobě | 245 |

5. OBLASTI A METODY VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH OBVODŮ VLSI

| | | |
|------|---|-----|
| 5.1. | Rozvoj integrovaných obvodů VLSI ve světě | 248 |
| 5.2. | Oblasti současných i budoucích aplikací integrovaných obvodů VLSI | 256 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 5.2.1. | Výpočetní technika | 257 |
| 5.2.1.1. | Počítač páté generace | 258 |
| 5.2.1.2. | Malé stolní počítače | 259 |
| 5.2.1.3. | Kancelářská a organizační technika | 259 |
| 5.2.1.4. | Aplikace mikroprocesorů a jednočipových mikropočítačů | 260 |
| 5.2.2. | Robotika | 261 |
| 5.2.3. | Automobilová technika | 263 |
| 5.2.3.1. | Perspektiva rozvoje automobilové techniky z hlediska použití elektroniky | 264 |
| 5.2.4. | Spotřebníelektronika | 267 |
| 5.2.4.1. | Další rozvoj spotřební elektroniky | 269 |
| 5.2.5. | Zdravotnictví | 269 |
| 6. | EKONOMICKÝ VÝZNAM MIKROELEKTRONIKY | 273 |
| 6.1. | Přínosy mikroelektroniky v oblasti použití | 273 |
| 6.2. | Ekonomie výroby integrovaných obvodů | 275 |
| 7. | ZÁVĚR | 279 |
| 7.1. | Perspektivy rozvoje aplikací integrovaných obvodů VLSI | 279 |
| 7.2. | Perspektivy rozvoje technologie | 281 |
| 8. | PŘEHLED NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ | 286 |
| 9. | SLOVNÍK | 302 |
| 10. | REJSTŘÍK | 312 |